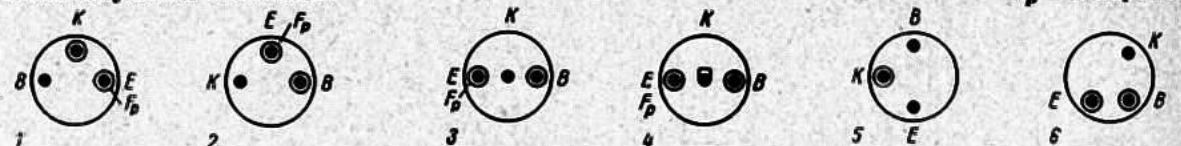


Daten sowjetischer Transistoren

F_p = Farbpunkt

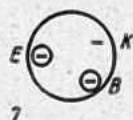


	$-U_{CB_0}$ in V	$-I_{c\max}$ in mA	$P_{\max}$ in mW	β	bei I_c in mA	$f_1[f\beta]$ in MHz	F in dB	Typ	Bemerkung	An- schluß- schema
П 42 А	15	30	200	30...50	10	1	—	pnп	Schalttransistor	8
П 42 Б	15	30	200	45...100	10	1	—	pnп		8
П 213 А	45	5000	10000	>20	—	0,15	—	npn	Silizium-HF- Transistor	12
П 213 Б	45	5000	10000	>40	—	0,15	—	npn		12
П 214 А	60	5000	10000	>20	—	0,15	—	npn		12
П 214 Г	60	5000	10000	>20	—	0,15	—	npn		12
П 216 Б	35	7500	24000	10	—	0,1	—	npn		12
П 216 В	35	7500	24000	30	—	0,1	—	npn		12
П 216 Г	50	7500	24000	5	—	0,1	—	npn		12
П 216 Д	50	7500	24000	15...30	—	0,1	—	npn		12
П 217 В	60	7500	24000	15...40	—	0,1	—	npn		12
П 217 Г	60	7500	24000	>18	—	0,1	—	npn		12
П 423	10	10	50	30...100	5	120	10	pnп	HF-Leistungs- transistor	4
П 504	30	10	150	10...35	—	>20	—	npn		5
П 504 А	30	10	150	25...80	—	>20	—	npn		5
П 505	20	10	150	40...150	—	>20	—	npn		5
П 505 А	20	10	150	20...60	—	>20	—	npn		5
П 607	15	200	1500	20...80	100	100	—	pnп		6
П 607 А	15	200	1500	60...200	100	100	—	pnп		6
П 608	15	200	1500	20...80	100	100	—	pnп		6
П 608 А	15	200	1500	60...200	100	100	—	pnп		6
П 609	15	200	1500	20...80	100	100	—	pnп		6
П 609 А	15	200	1500	60...200	100	100	—	pnп		6
П 702	70	2000	4000	25	1000	4	—	npn	Silizium-HF-Lei- stungstransistor	7
П 702 А	70	2000	4000	10	1000	4	—	npn		7

МП 37 А	30	20	150	15...30	1	1	—	npn	speziell für Fernsehgeräte	8
МП 37 Б	30	20	150	25...50	1	1	—	npn		8
МП 38 А	15	20	150	45...100	1	2	—	npn		8
МП 39 Б	20	20	150	20...60	1	0,5	—	pnп		8
МП 40	20	20	150	20...40	1	1	—	pnп		8
МП 40 А	20	20	150	20...40	1	1	—	pnп		8
МП 41	20	20	150	30...60	1	1	—	pnп		8
МП 41 А	20	20	150	50...100	1	1	—	pnп		8
ГТ 108 А	15	10	75	20...50	1	[0,5]	—	pnп	Miniaturtran- sistor für Unter- haltungs- elektronik	1
ГТ 108 Б	15	10	75	35...80	1	[1]	—	pnп		1
ГТ 108 В	15	10	75	60...130	1	[1]	—	pnп		1
ГТ 108 Г	15	10	75	110...250	1	[1]	—	pnп		1
ГТ 109 А	15	20	30	20...50	1	1	—	pnп		0
ГТ 109 Б	15	20	30	35...80	1	1	—	pnп		0
ГТ 109 В	15	20	30	60...130	1	1	—	pnп		0
ГТ 109 Г	15	20	30	110...250	1	1	—	pnп		0
ГТ 109 Д	15	20	30	20...70	0,1	3	—	pnп	Miniatur- transistor	0
ГТ 109 Е	15	20	30	50...100	0,1	5	—	pnп		0
ГТ 308 А	20	50	150	20...75	10	>20	8	pnп		4
ГТ 308 Б	20	50	150	50...120	10	>20	8	pnп		4
ГТ 308 В	20	50	150	80...200	10	>20	8	pnп		4
ГТ 309 А	10	10	50	20...70	1	>20	—	pnп		2
ГТ 309 Б	10	10	50	60...180	1	>20	10	pnп		2
ГТ 309 В	10	10	50	20...70	1	>20	—	pnп		2
ГТ 309 Г	10	10	50	60...180	1	>20	10	pnп	Miniatur- transistor	2
ГТ 309 Д	10	10	50	20...70	1	>20	—	pnп		2
ГТ 309 Е	10	10	50	60...180	1	>20	—	pnп		2
ГТ 310 А	12	10	20	20...70	1	>20	3	pnп		0
ГТ 310 Б	12	10	20	60...180	1	>20	3	pnп		0
ГТ 310 В	12	10	20	20...70	1	>20	4	pnп		0
ГТ 310 Г	12	10	20	60...180	1	>20	4	pnп		0
ГТ 310 Д	12	10	20	20...70	1	>20	4	pnп		0
ГТ 310 Е	12	10	20	60...180	1	>20	4	pnп		0

Daten sowjetischer Transistoren

(Fortsetzung)



	$-U_{CB0}$ in V	$-I_{c\max}$ in mA	$P_{\max}$ in mW	β	bei I_c in mA	$f_c [f_\beta]$ in MHz	F in dB	Typ	Bemerkung	An- schluß- schema
ГТ 311 А	12	20	150	15...180	15	100	—	npn		11
ГТ 311 Б	12	20	150	30...180	15	100	—	npn		11
ГТ 311 В	12	20	150	15...50	15	100	—	npn		11
ГТ 311 Г	12	20	150	30...80	15	100	—	npn		11
ГТ 311 Д	12	20	150	60...180	15	100	—	npn		11
ГТ 313 А	15	10	100	20...250	5	> 300	—	pnp		11
ГТ 313 Б	15	10	100	20...250	5	> 450	—	pnp		11
ГТ 320 А	20	150	200	20...80	10	130	—	pnp		4
ГТ 320 Б	20	150	200	50...120	10	200	—	pnp		4
ГТ 320 В	20	150	200	80...250	10	260	—	pnp		4
ГТ 701 А	60	12000	50000	10	5000	0,05	—	pnp		6
КТ 601 А	100	30	500	16	10	40	—	npn	Planartransistor	6
КТ 801 А	80	2000	5000	13...50	1000	10	—	npn		10
КТ 801 Б	60	2000	5000	20...100	1000	10	—	npn		10
КТ 802 А	150	5000	50000	15	2000	10	—	npn	Planartransistor für Fe-Geräte	7
1Т 303 А	12	10	100	15...50	—	> 20	—	npn	Germanium- HF-Transistor	4
1Т 303 Б	12	10	100	30...80	—	> 20	—	npn		4
1Т 303 В	12	10	100	60...160	—	> 20	—	npn		4
1Т 303 Г	12	10	100	15...50	—	> 20	—	npn		4
1Т 303 Д	12	10	100	30...80	—	> 20	—	npn		4
1Т 303 Е	12	10	100	60...160	—	> 20	—	npn		4
1Т 308 А	20	50	150	25...75	—	90	—	pnp		3
1Т 308 Б	20	50	150	50...120	—	120	—	pnp		3
1Т 308 В	20	50	150	80...150	—	120	—	pnp		3
1Т 308 Г	20	50	150	100...300	—	120	—	pnp		3
1Т 403 А	45	1250	—	20...60	100	[0,008]	6	pnp	R_{th1} in °C/W 15	10
1Т 403 Б	45	1250	—	50...150	100	[0,008]	—	pnp	15	10
1Т 403 В	60	1250	—	20...60	100	[0,008]	—	pnp	12	10
1Т 403 Г	60	1250	—	50...150	100	[0,006]	—	pnp	15	10
1Т 403 Д	60	1250	—	50...150	100	[0,006]	—	pnp	15	10
1Т 403 Е	60	1250	—	> 30	450	[0,008]	—	pnp	12	10
1Т 403 Ж	80	1250	—	20...60	100	[0,008]	—	pnp	15	10
1Т 403 И	80	1250	—	50...150	100	[0,008]	—	pnp	15	10
2Т 301	10	10	150	20...60	—	30	—	npn	Silizium-HF- Transistor	2
2Т 301 А	10	10	150	40...120	—	30	—	npn		2
2Т 301 Б	10	10	150	10...32	—	30	—	npn		2
2Т 301 В	10	10	150	20...60	—	30	—	npn		2
2Т 301 Г	10	10	150	10...32	—	30	—	npn		2
2Т 301 Д	10	10	150	20...60	—	30	—	npn		2
2Т 301 Е	10	10	150	40...120	—	60	—	npn		2
2Т 301 Ж	10	10	150	80	—	60	—	npn		2